

2011 年度 応用物理学会シリサイド系半導体・夏の学校

プログラム

7月 19 日(火)

12 : 00 受付開始, 事務連絡, 開催挨拶 (大会議室)

13 : 00 招待講演1 安藤裕一郎先生 (九州大学)

「Si 上における強磁性シリサイド Fe_3Si の高品質形成と Si へのスピン注入」

14 : 15 招待講演2 伊藤博介先生 (関西大学)

「強磁性金属／半導体接合の電子状態とスピン注入」

15 : 30 休 憩

部屋割・鍵配布・チェックイン

16 : 00 招待講演3 山田高広先生 (東北大学)

「アルカリ金属を利用したシリサイドの新しい合成手法とその応用」

17 : 30 休 憩

入 浴 (大浴場 17 : 00～22 : 00)

18 : 30 夕 食 (アゴラホール)

20 : 30 休 憩

20 : 45 招待講演4 寺井慶和先生 (大阪大学)

「 $\beta\text{-FeSi}_2$ の発光およびバンド構造評価の進展」

22 : 00 研究会・幹事会 (鶴殿委員長) (国際交流ホール)

24 : 00 終了

7月 20 日(水)

7 : 30 ~ 8 : 30 朝食 (2 階食堂)

8 : 30 チェックアウト

9 : 00 招待講演5 鵜殿治彦先生 (茨城大学)

「熱電の基礎とシリサイド半導体の可能性」

10 : 00 休 憩

一般講演1 座長 前田佳均 (京大)

10 : 15 ○根本怜, 永野隆敏 (茨城大)

「 β -FeSi₂ 表面構造における欠陥と磁性の発現の可能性

ー 第一原理による予測 ー」

10 : 30 ○兼子泰幸, 鈴木基史, 中嶋薫, 木村健二 (京大院・工)

「斜めスパッタ堆積法による FeSi₂ 周期ナノコラム構造の形成」

10 : 45 ○松村精大, 山中雄介, 鵜殿治彦 (茨城大), 山口憲司, 江坂文孝,

北条喜一 (原子力機構)

「Si 照射下での β -FeSi₂ 基板熱処理とホモエピタキシャル成長」

一般講演2 座長 鈴木基史 (京大)

11 : 00 ○野田慶一, 寺井慶和, 米田圭佑, 三浦直行 (阪大), 鵜殿治彦 (茨城大), 藤原康文 (阪大)

「Si (001) 基板上 β -FeSi₂ エピタキシャル膜における PR スペクトルの成長条件依存性」

11 : 15 ○五十嵐誉, 鈴木翔治, 小澤俊平, 菅原宏治 (首都大・SD)

「無容器電磁浮遊法を用いた鉄シリコン二元融液の表面張力の測定」

11 : 30 ○中島孝仁, 西村健太郎, 前田佳均 (京大院エネルギー科学)

「 β -FeSi₂ ナノ結晶の発光特性 : C バンド発光挙動」

11 : 45 おわりの挨拶, 事務連絡 (送迎バス案内)